



性能特点：

- 频率范围：2~18GHz
- 增益：21dB
- 噪声系数：1.5dB
- 饱和电流：59mA
- 关断电压：-0.85V
- 芯片尺寸：0.42mm×0.45mm×0.1mm

产品简介：

通用型砷化镓 FET 管芯，适用于 12GHz 以内的中等功率放大器，宽带放大器，线性驱动放大器等。

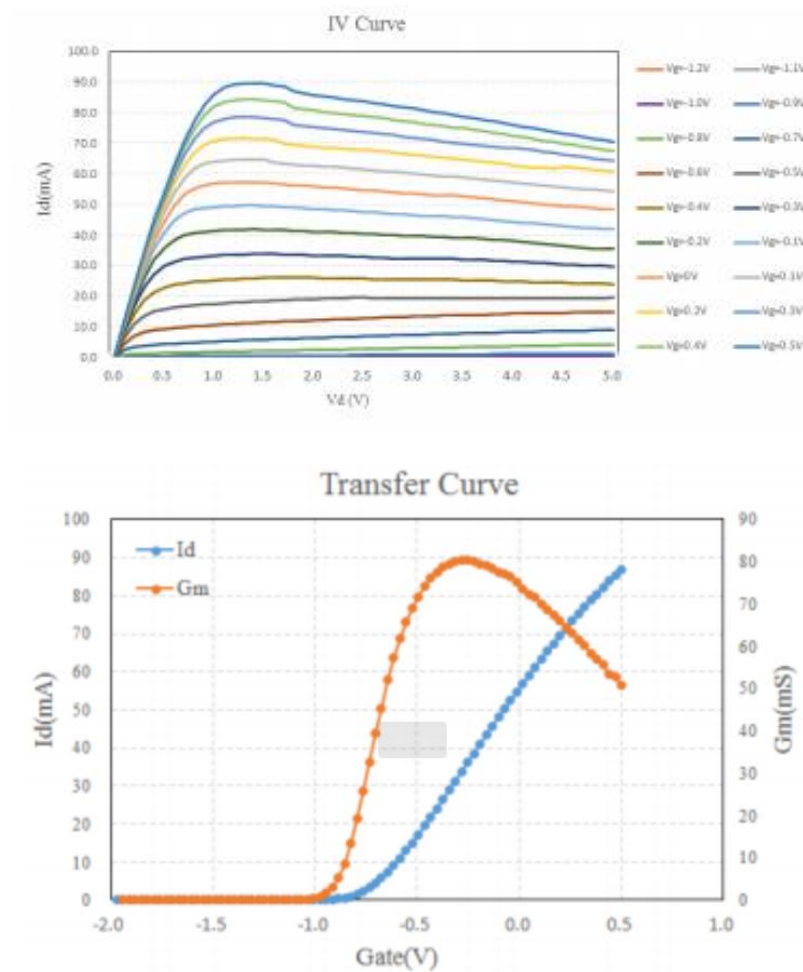
电参数：(TA=25℃)

指标	条件	最小值	典型值	最大值	单位
饱和电流	VDS =3V , VGS =0V	50	59	70	mA
跨导	VDS =3V , IDS =27mA	50	76	90	mS
关断电压	VDS =3V , IDS =2.7mA	-0.6	-0.85	-1.2	V
栅漏击穿电压	IDG =2.7μA	18			V
噪声系数	VDS =3V , IDS =10mA@8GHz		1.2		dB
	VDS =3V , IDS =10mA@12GHz		1.5		
功率增益	VDS =3V , IDS =10mA@8GHz		12		dB
	VDS =8V , IDS =0.7IDSS@8GHz		21		
	VDS =8V , IDS =0.7IDSS@12GHz		21		
饱和输出功率	VDS =3V , IDS =10mA@8GHz		19		dBm
	VDS =8V , IDS =0.7IDSS@8GHz		23		
	VDS =8V , IDS =0.7IDSS@12GHz		23		

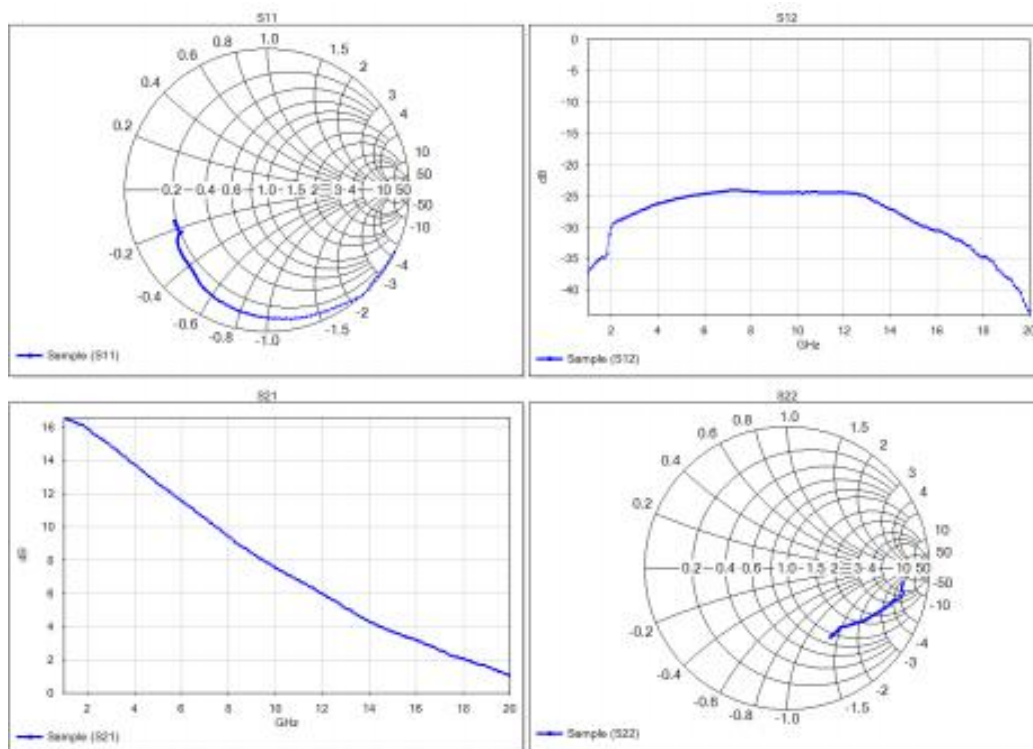


典型曲线:

DC 测试



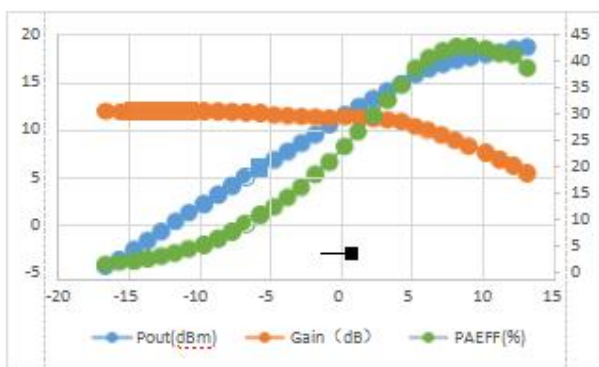
小信号 S 参数



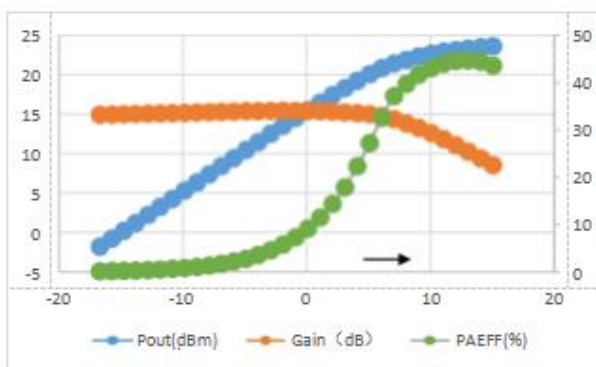
(注: 测试条件 $V_{DS}=8V$, $I_{DS}=34mA$)

负载牵引测试

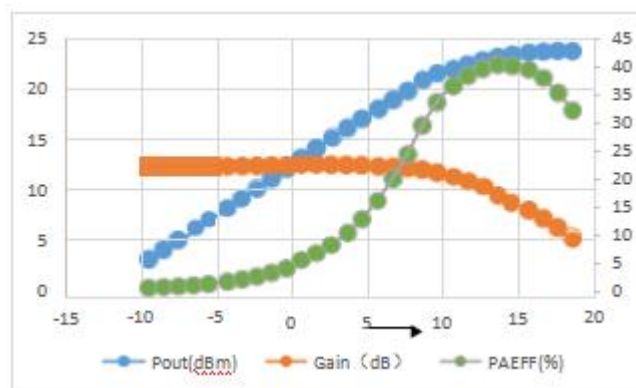
$V_d=3V$, $I_d=10mA@8GHz$



$V_d=8V$, $I_d=0.7I_{dss}@8GHz$

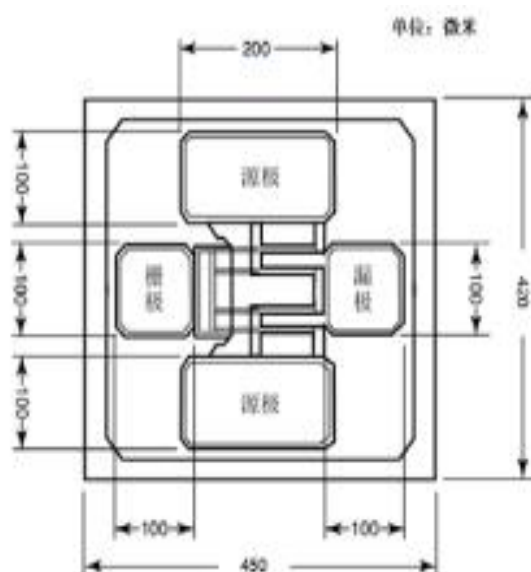


$V_d=8V$, $I_d=0.7I_{dss}@8GHz$





芯片尺寸图: (单位 mm)



使用注意事项:

- 1、在净化环境中使用, 使用时不要碰触芯片表面。
- 2、干燥、氮气环境储存。